▋技術報告 ■

プラズマ・イオンプロセスによる FeSi2アモルファス熱電材料の開発

Amorphous FeSi₂ Alloys as a New Thermoelectric Material developed by Plasma Ion Processing

1. はじめに

年間約2億kdにもなるわが国の膨大な廃熱エネルギ ーの有効利用の問題は、化石燃料の資源対策やCO₂に よる環境汚染の問題とも絡んで、対策を要する緊急の 課題である.筆者らは、その一端を担うエネルギー変 換技術として熱→電気直接変換をとりあげ、プラズマ ・イオンによる新素材開発を行っている。

熱電発電(TEC)の研究は、1960年以来、Pu²⁸⁶を 熱源とする電気出力3~0.5kW級の小型の人工衛星用 電源や¹⁾,太陽熱エネルギー、原子炉、工場廃熱ガス の有効利用を目的とした熱電発電器の開発が進められ ている^{2)~4)}.1986年には、30kW級のプロトタイプ熱 電発電システム⁴⁾が米国エネルギー研究所で高温廃熱 エネルギーの回収用として開発されており、研究が大 電力化の方向に向かっている。

熱電発電器の変換効率は、熱電材料の性能指数(figure of merit) と呼ばれる物質パラメータによって決 まる.これは、 $z=S^2\sigma / \kappa$ (Sはゼーベック係数, σ は電気伝導度、 κ は熱伝導率)で表わされる.

一例として、代表的な熱電材料のzの値を温度の関数として図-1に示す. この中では、 Bi_2Te_3 系カルコゲン化合物が最も大きな値をもち、 $z\sim10^{-3}$ (1/deg)である. この値が実用化の一つの目安になっており、これを越える材料開発が急務の課題である.

ここでは、筆者らが現在研究を行っているアモルフ ァスFeSi₂系合金薄膜について、その原子構造、伝導 機構、熱電材料としての特性について述べる.また、 $O_2 - ガス雰囲気中でプラズマ処理したFeSi₂ 微結晶粒$ $子(粒径0.5~3 <math>\mu$ m)のセラミック熱電材料の結果 について述べる.

2. FeSi2系アモルファス薄膜の熱電特性



の温度特性

FeSi₂, MnSi₂, CrSi₂などの3d-遷移金属化合物 は、カルノー効率が高い高温度領域で比較的電気出力 が高く、熱的に安定な物質である^{5).6)}これらの物質は、 O₂, N₂, C₂H₂(またはCH₄)などの反応性ガス中 でクラスターイオンビーム(ICB)蒸着すると、アモ ルファス構造になる^{7)~10}.また、イオンアシスト(ion assisted)法で、例えばFeと一酸化ケイ素(SiO)を 反応させると、島状(granular)構造の薄膜が堆積 する^{12)~14}.

イオンアシスト蒸着法(以下,これをIAD法と略す) の系統図を図-2に示す.この装置には,電気出力5 kWの電子ビーム(EB)主蒸着源の他に,ICB型のサ ブ・イオン源が付加してある.

この研究では、EB蒸着源に源料としてFeを、サブ・ イオン源のるつぼに一酸化ケイ素(SiO)を入れて加 熱し同時蒸着した.SiO薄膜の堆積速度はイオン化電 子電流 Ie,加速電圧Vaによって異なるが、Ie~300 mAでの堆積速度は~ $20 \, \mu \, m / hr$ である.

薄膜形成は、チャンバーの真空度~5×10⁻⁶Torr,

松原覚衛* Kakuei Matsubara

^{*}山口大学工学部電気電子工学科教授 〒755山口県宇部市常盤台2557



図-2 イオンアシスト (IAD) 蒸着法の系統図

基板温度Ts~500℃で行い,基板にはガラス(または 溶融石英)を用いて行った.また,薄膜の組成分析はE PMAにより行った.FeとSiOとを同時蒸着した薄膜 (Fe/Si~0.5)の透過電子顕微鏡写真(TEM像)を, 一例として図-3に示す.また,この膜の電子線回折像 (HEED)を図の左上に示す.



図-3 IAD法で蒸着したFe-SiO薄膜の透過 電子顕微鏡(TEM)像と電子回析 (HEED)パターン







図-5 これらの薄膜の電気伝導度σの温度特性

この結果に見るように、基板上に凝集した粒径~ 100ÅのFeの超微粒子が非晶質のSiO(または、SiO₂) 中に均一に分布しており、明らかな島状構造を呈して いる.この膜のHEEDパターンより求めた格子間隔 はd~20Åで、これはFeの(110)面間隔に対応して いる.



 図-6 FeとSiOとの組成比の異なるグラニュラー 薄膜の電気伝導度σの温度特性: ιnσ-10³/T^{1/2}特性

図-4.5は、Fe/Si~0.5の薄膜をAr中で500℃、4 hr熱処理した試料の熱起電力(ゼーベック係数)Sと 電気伝導度 σ の 温度特性 (○印) を 示す. 図には, IC Bによって堆積したFeSi®アモルファス薄膜(点線) とβ-FeSi₂結晶膜の結果(△印)も比較して示して ある、この結果から、グラニュラー構造膜は~数mV /degの高い熱起電力が比較的広い温度範囲にわたっ て生じている.しかし、低温度領域での電気伝導度 σ の値はICBの場合と比較して~2ケタ低い.

グラニュラー構造膜の電気伝導は、図-6に示すトン ネル型伝導モデルで説明できる.このときの電気伝導 度σは,

 $\sigma \propto \exp \left(-B/kT^{1/2}\right)$ (1)

で与えられる、ここで、Bはトンネル確率とポテンシャ ル障壁幅に関係する比例係数は、kはボルツマン定数 である.

Fe/Si比の異なるグラニュラー薄膜について、電 気伝導 σをT^{1/2}に対してプロットすると、図-6の結果 が得られる. 横軸が10³/T^{1/2}=20~40の範囲で(1)式 を満している.



図-7 FeSi2微結晶 (0.5~2 µm)のTEM像: (a)未処理、(b)O2-プラズマ処理後

3. プラズマ処理したFeSi2微粒子の セラミックス熱電素子の研究

粒径0.5~2 μmの FeSi₂微結晶粒子をO₂-ガス・プ ラズマ中で処理したセラミックス焼結体について、熱 電材料としての評価を行った13),14).

原料として用いたFeSi2粉体は、不活性ガス(Ar) 雰囲気中で直流アーク放電によって熔融した後、ボー ル・ミルで平均粒径0.5~2 µmまで粉粋したもので ある、プラズマ処理は、O2-ガス圧~0.1、1 Torr、高 周波パワー(13.56MHz)~500Wで行い、処理時間 は2~3hrである.

O2-プラズマ中で処理したFeSi2 微粒子の断面の透



プロファイル: (a)未処理, (b)O2-プラズマ処 理後

過電子顕微鏡写真(TEM)構造を,未処理の場合と 比較して図-8(a), (b)に示す. 図の(a)は未処理, (b)はO2-プラズマ処理後の結果である、未処理の場合は結晶格 子の周期構造が見られ、プラズマ処理を行った場合で は周期構造に明らかな乱れがある.

図-8(a), (b)は結晶表面から深さ方向のFe, Si, O元素 のプロファイルを示したものである. 図の(a)は未処理、 (b)はO₂-プラズマ処理後の結果である.(b)の場合,Ar のイオンビームによるFeSi。のスパッターレートが SiO₂ 換算で~150Å/minであるので、O₂-プラズマ処 理をしたFeSi2では結晶表面から~0.2µmの深さま で酸素が侵入して格子中のSi-原子と結合しているこ とがわかる.これに対して、未処理の場合はFeSi2の 結晶表面に薄い自然酸化層(~30ÅのSiO2膜)が形 成しており、それより深い位置では酸素の侵入はない ことがわかる.

FeSi2の微結晶粒子をO2-プラズマ中で処理した後, この粉体にバインダーとしてポリビニール・アルコー ル (PVA) 1%を加え、~3 ton/cm²で加圧成型し、 これをAr雰囲気中~1,170℃で焼結した試料について 熱電材料としての特性評価を行った.



図-9 FeSi₂(P)とCo_{0.03}Fe_{0.07}Si₂(n)セラ ミックスの熱起電力Sの温度特性

図-9, 10に、上述の条件でプラズマ中で処理したFe Si₂ (p-type)と、不純物としてCoを3%ドープした Co_{0.08}Fe_{0.97}Si₂ (n-type)セラミックス試料の熱起電 力Sと電気伝導度 σ の温度特性の一例を示す. 図には 比較のためにプラズマ処理前の試料の測定結果を点線 で示してある.

この結果から次のことがわかった.まず,FeSi₂ (P-type) 試料では,プラズマ処理前の熱起電力の最 大値は~400Kの温度領域でS_{peak}~0.25mV/degであ る.次に,これをO₂-プラズマ処現すると約3倍の~ $0.9mV/degまで増加している.一方,電気伝導度 <math>\sigma$ はO₂-プラズマ処理したものは10³/T~2 (~500K) 以下で増加しており,未処理の場合と比べると構造欠 陥が明らかに消滅していることがわかる.

一方、Co.usFeuerSi2 (n-type)の未処理の場合~500
 k以下でS~0.3mV/deg,また~500Kより高い温度
 領域で急激に減少している.これに対して、O2-プラ





ズマ処理したものは,高温度ほど熱起電力Sは増加す る傾向を示し,~800Kでピーク値Speak~0.36mV/deg である.電気伝導度は O_2 -プラズマ処理によってわず かに減少しているが, σ ~ $10^2 \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$ である.この 温度特性からほぼ縮退濃度(~ 10^{20} cm) に近いキャリ ヤー濃度になっている.

この結果, O_2 -プラズマ処理したFeSi₂セラミック スの熱電材料としての性能指数Z(=S² $\sigma \not \kappa$) は, 未処理のものより少なくとも10倍以上は性能アップし ている.

このセラミック試料を用いてU-形の熱電素子をつ くり、これについて発電実験を行った.発電素子のサ イズは、p-type、n-typeとも素子長さ1~1.3cm、断 面積A~0.04cm (0.2cm×0.2cm)である.

図-11は、このU-形の熱電素子での発電実験の結果 を示したものである.このU-形素子の加熱温度と放 熱端の温度は、それぞれT_b~800℃、T_c~200℃であり (温度差: Δ T~600℃)である.この動作条件で、出 力端開放電圧V_o~0.48volt、短絡電流I_o~18.5amp/ c㎡が得られている.図中のU-1、2の記号は、素子1 対の場合と2つを直列に接合したことを意味する.



図-11 FeSia系U-字型熱電素子の電圧-電流特性



図-12 FeSi²熱電素子(新素材)の発電実験

Vol. 12 No. 3 (1991)

図には、比較のために燃料電池(fuel cell)とアルカ リ金属熱電発電(AMTEC)で知られている出力特 性を併せて示してある(点線).図-12の写真は、この U-形の熱電素子の発電実験の様子を示している.

4. むすび

熱電発電の実用化を目的として、イオン・アシスト (IAD) 法によるFeSi₂アモルファス薄膜生成と、Fe Si₂微結晶粉体のプラズマ処理によるセラミックス熱 電素子についての研究結果について報告した.

本研究で得られた主な結果は次の通りである. (1) FeのEB蒸着とSiOのイオン照射を併用して堆積したFeSi₂薄膜は,熱処理すると島状(granular)構造になる.この膜の熱起電力は比較的広い温度領域にわたって~8mV/degが得られるが,電気伝導度 σ は10⁻³~1 Ω^{-1} cm⁻¹と低いので,材料プロセス面での改良が心要である.この薄膜の電気伝導はトンネル伝導機構で説明できる.

(2) FeSi₂微結晶粉体をO₂-プラズマ(13.56MHz)中で処理した後,焼結したセラミックスは,未処理の場合に比較して熱起電力が~3倍以上高くなり,熱電材料としての性能指数は~10倍増加する.

以上, プラズマ・イオンプロセスによる新材料開発 で, 熱電発電のブレークスルーの可能性に示した. ま だ, いくつかのハードルを越す必要はあるが, この研 究が実用化に向って大きく前進したことは確かである. このシード研究が, 国際的な規模で大きく発展するこ とを願っている.

謝 辞

本研究は、文部省科学研究費(エネルギー重点領域 研究)の交付を受けて行ったものである.この新素材 開発にあたって、プラズマ・イオンプロセス装置開発, 材料の特性評価、TEM構造の観察など、宇部興産㈱ UBE研究所の多大の協力を得た.ここに、誌面を借 りて感謝の意を表する次第である.

文 献

- 1) K. F. Gantz: Nuclear Flight, (1960) 138.
- R. Ramakumae : "Review of Solar Pounds", 14th Front Power Conf., (1981) 11.
- 3) R. C. Schling : Adv. Energy Conv., 2 (1962) 229.
- J. Beaden et al. : Proc. 6 th Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion, (1968) 138.
- U. Birkholz and J. Schelm : Phys. Stat. Sol., 34 (1969), K177.
- 6) I. Nishida : J. Mater. Sci., 7 (1972) 435.
- K. Matsubara, H. Takaoka and T. Takagi : Proc. Int. Conf. on Ion Engin. Congress, ISIAT '83 & IPAT '83 (1983) 1221.
- 8) K. Matsubara, T. Koyanagi and T. Takagi : Proc.
 6 th Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion, Texas USA, (1986) 1.
- 9) K. Matsubara, T. Koyanagi aud T. Takagi, Proc. 11th Symp. on Ion Sources and Ion Assisted Technology, (1987) 443.
- K. Matsubara, T. Koyanagi and T. Takagi : The lst European Conference on Thermoelectrics, IEE Materials & Devices Series 7 (edited. by D. M. Rowe), (1988) 198.
- 11) 松原覚衛:材料科学, Vol. 27, No. 5 (1990) 270.
- 12) K. Nagao, M. Suehiro, K. Kawamura, K. Ishida, T. Koyanagi, and K. Matsubara : Proc. 13th Symp. on Ion Sources and Ion Assisted Technol., (ISIAT'90), (1990) 245.
- 13) 松原覚衛, 嶺村則道, 三木俊克, 長尾圭吾, 小柳 剛: 文部省エネルギー重点領域研究, 平成2年度研究報告書 p. 279.
- 14) T. Miki, K. Nagao, Y. Kadonaga and K. Matsubara : Characterization of Granular Fe-SiO Films by means of Electron Paramagnetic Resonance. (submitted to J. Appl. Phys.)
- K. Matsubara : Science and Technology for Energy Conversion, (Subarea C), (1990) 323.
- 16) K. Matsubara, N. Minemura, K. Nagao and T. Koyanagi : Science and Technology for Energy Conversion, (Subarea C), (1990) 327.